



新闻动态

- ▶ 图片新闻
- ▶ 头条新闻
- ▶ 综合新闻
- ▶ 学术活动
- ▶ 科研动态
- ▶ 通知公告
- ▶ 业内信息
- ▶ 合作交流

现在位置：首页 > 新闻动态 > 综合新闻

南洋理工大学周兴教授来微电子所进行学术交流

2011-11-18 | 编辑：三室 张康玮 | 【大】 【中】 【小】 【打印】 【关闭】

11月15日，新加坡南洋理工大学周兴教授来微电子所进行学术交流。并作了题目为 Unification of MOS Compact Models with the Unified Regional Modeling Approach 的精彩报告。

报告中，周兴教授详细分析了目前已有的MOS模型以及各种模型的优缺点，并提出了一种集约模型——Xsim。Xsim集约模型通过同一区域化的方法可以统一MOSFET模型。他认为，相比于其他MOSFET模型，Xsim集约模型在模拟和验证统一化的MOSFET架构中的一些现象和规律时能同时兼顾新结构中的计算精度和计算速度，比如在部分耗尽（PD）、全耗尽（FD）、超薄体硅器件（UTB）、对称或非对称双栅结构（s-DG/a-DG）器件中的应用。并且Xsim模型能以最少的物理参数来用于SPICE一类的仿真软件验证肖特基势垒型的MOSFET中的双极性电流和模拟不对称的源/漏MOSFET等等。听完周教授的报告，与会者纷纷表示很受启发，认为Xsim集约模型对以后的模型研究工作很有借鉴和参考价值。

周兴教授于1990年在罗切斯特大学获得博士学位。1992年加入南洋理工大学的电器与电子工程学院，现担任副教授。目前主要研究方向是集约模型电路模拟中的发展和应用。他曾经担任过斯坦福大学、广岛大学和马来西亚理工大学的客座教授。2002年至今，任集约模型座谈讨论会的主席。此外，还是IEEE EDS（IEEE Electron Devices Society）执行委员会的成员，从2000年开始，担任EDS的讲师。2007年至今，担任《IEEE Electron Device Letters》期刊的编辑。



讲座现场

附件下载:



中国科学院微电子研究所版权所有 邮编: 100029

单位地址: 北京市朝阳区北土城西路3号, 电子邮件: webadmin@ime.ac.cn

京公网安备110402500036号